

マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点(ARIM)ご利用をご検討の皆様

2024 年度（令和 6 年度）ARIM 利用申請のご案内いたします

マテリアル先端リサーチインフラ事業においては、装置利用に伴い創出されるマテリアルデータを利活用すべく、昨年度よりデータ提供を検討いただける場合には、ARIM 利用料割引を適用しております。

今年度より利用料金の上限額の月極及び年極金額の改訂がございます。また、りざぶ郎にて予約しておりましたが、SimpRent にて予約から請求まで（利用金額確認）することができるシステムを導入致しました。

原則、申請承認後のデータ提供意思表示の変更はできかねますことご了承ください。

利用申請書を「ダウンロード後」に入力作成をお願い致します。（**手書不可**）

申込宛先： info-nanoplat@sanken.osaka-u.ac.jp

※送付の際は件名に「申請書提出_所属（研究室名等）」を記入の上、送付ください。

また課題名につきましては、SimpRent 内で表記されますのでご注意ください。

・エクセルのリストには「施設利用者様(申請者様含む)」と「事務担当者様」の情報入力が必要です。

・研究不正確認日付、保険加入のチェックが漏れなく必要です。

・お申し込み後約 2 週間内を目安に「仮利用許可証」等一式をメールで送付致しますのでお受け取り後に施設利用をして頂けます。

・SimpRent への「課題」、「ユーザー」の登録は当事務局で登録を行います。

※ 申請書にて提出している「予算」は当事務局で登録を行います。ただし、申請書提出時以外の予算を使用したい時は「予算登録」を各々行ってください。

どうぞよろしくお願ひ申し上げます。

大阪大学 産業科学研究所

マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点 (ARIM)

〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1

info-nanoplat@sanken.osaka-u.ac.jp

文部科学省委託事業【マテリアル先端リサーチインフラ】
大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点

令和6年度支援利用申請書【ARIM微細加工/ARIM物質合成部門用】

令和 年 月 日

大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点長 殿

支援利用申請者

氏 名：

NAME：

職 名：

所 属：

所 在 地：〒

TEL：

E-mail：

年齢区分： 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代以上

指導教官（申請者が学生／院生の場合）

氏 名：

NAME：

職 名：

所 属：

下記のとおりマテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点を利用したいので申請します。

記

1. 申請課題名

和文：

Eng：

※SimpRentでは課題名が表記されますのでご注意ください。

2. 支援利用での希望

支援利用による成果： 公開（成果公開事業） 非公開（成果非公開事業）

3. データ提供の意思確認

データ提供： する しない

4. 希望する支援利用形態（申請時は複数選択可）

- (1) 機器利用
- (2) 技術代行
- (3) 技術補助
- (4) 協力研究/共同利用
- (5) 技術相談

5. 利用の期間（年度内）

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

6. 利用したい装置【ARIM 微細加工部門・ARIM 物質合成部門支援提供装置】

↓利用したい装置の欄にチェック ※装置稼働状況はWebサイトをご確認ください。

レ 印	装置 番号	ARIM 装置番号	設備（設備群）名	メーカー・機種	CR
	F11	OS-101	高精細集束イオンビーム装置 (NanoFab)	ZEISS “ORION NanoFab”	
	I21	OS-114	RF スパッタ成膜装置（金属成膜用）	サンヨー電子 “SVC-700LRF”	○
	I22	OS-115	RF スパッタ成膜装置（絶縁体成膜用）	サンヨー電子 “SVC-700LRF”	○
	I23	OS-110	リアクティブイオンエッチング装置 (10NR)	サムコ “RIE-10NR-NP”	○
	I24	OS-109	深掘りエッチング装置（400iPB）	サムコ “RIE-400iPB-NP”	○
	I25	OS-103	超高精細電子ビームリソグラフィ装置 (125keV EBL)	エリオニクス “ELS-100T”	○
	N01	OS-102	SEM 付集束イオンビーム装置 (Nvision)	ZEISS “Nvision 40D with NPVE”	●
	N02	OS-111	リアクティブイオンエッチング装置 (10NOU)	サムコ “RIE-10NOU”	●
	N03	OS-113	多元 DC/RF スパッタ装置	キヤノンアネルバ “EB1100”	●
	N04	OS-116	誘導結合型 RF プラズマ支援スパッタ 装置（ICP-RF スパッタ装置）	アルバック “MB02-5002”	●
	N05	OS-117	EB 蒸着装置	アルバック “UEP-2000 OT-H/C”	●
	N07	OS-126	接触式膜厚測定器	BRUKER “DektakXT-A”	●
	N08	OS-107	マスクアライナー	ミカサ “MA-10”	●
	N09	OS-105	高速大面積電子ビームリソグラフィ 装置（50keV EBL）	エリオニクス “ELS-S50LBC”	●
	N10	OS-104	自動搬送電子ビーム描画装置（150kV BODEN）	エリオニクス “ELS-BODEN- OU4801”	●
	N31	OS-127	レーザーラマン顕微鏡	ナノフォトン “RAMAN-touch VIS-NIR-OUN”	
	N32	OS-125	走査型プローブ顕微鏡	日立ハイテクサイエンス “AFM5000/AFM5300E”	
	N33	OS-128	物理特性測定装置（PPMS）	日本カンタム・デザイン “DynaCool-9”	
	N62	OS-119	自動制御型パルスレーザー蒸着ナノマ テリアル合成装置	パスカル “MC-LMBE”	
	S01	OS-108	ナノインプリント装置	Obducat “Eitre 3”	●
	S32	OS-120	薄膜 X 線回折装置	リガク “Ultima IV”	
	S35	OS-123	ナノ粒子解析装置（ゼーターサイザ ー）	シスメックス “NANO-ZS”	

CR 欄に○もしくは●がある装置はクリーンルーム内に設置されています。入室時にクリーンルーム入室料が別途加算されます。

利用申請書提出後の利用したい装置の追加は可能です。

【※付帯装置の課金について】

以下の装置については利用したい装置としての申請は不要ですが、課金対象装置になります。ご利用の際はご注意ください。

装置番号	設備（設備群）名	メーカー	CR
N71	タングステンコーター	エリオニクス	●
N72	プラズマクリーナー	日本電子	●
N73, I73	スピンコーター	ミカサ	●○
N74	UV オゾンクリーナー		●
N75	ワイヤーボンダー		

7. 本申請課題に関連した助成金・競争的資金

本申請課題に関連した助成金や競争的資金を得ている場合、その資金名および課題名（該当なき場合は「なし」と記入）

資金名： _____

プロジェクトコード： _____

所管コード： _____

※学内：資金名にプロジェクト名をご記入ください。プロジェクトコードと所管コードは必ずご記入ください。
学外：『外部振込』とご記入ください。

課題名（任意）： _____

（利用負担金の実際の支払い財源の問い合わせではありません。助成金や競争的資金の申請課題を実施するあたり、研究・開発計画の一部について当拠点を利用して進める場合にご記入ください。）

8. 経理担当者(研究室内の会計担当者など)

(すべての項目を正確に記入してください)

氏 名：

NAME：

職 名：

所 属 名：

所 在 地：〒

TEL：

E-mail：

9. 当拠点を利用するきっかけ（新規申請の方のみ 任意記入）

申請上の注意点

本申請書の提出時には、必ず上長・指導教官等契約権限を委任された者の承諾を得てください。当拠点への本申請書の提出をもって、拠点利用規程（ARIM微細加工部門・ARIM物質合成部門）を遵守の上で当拠点を利用することおよび当拠点から支援を受けることに同意したことになります。秘密保持契約等別途合意文書等が必要な場合は拠点までご相談ください。

ユーザーへ案内の際には以下に「大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点 利用規定」を付ける。